

đều giảm tuyến tính khi nhiệt độ tăng, với hệ số nhiệt sai nhau cỡ 10^{-3}°C [3, 4] chính hoàn toàn được thực hiện qua nguồn dòng nuôi cho diốt phát quang. Kiểm tra thử cho thấy sự sai khác độ dịch phổ giữa bức xạ γ và NXSC khoảng 10^{-4}°C . Với dòng nén diốt phát quang cho xung sáng trong ứng bức xạ γ năng lượng 3,2 Mev. Tạp âm do Nernst vàc hệ đo là không đáng kể.

III. KẾT QUẢ

Khối O. D. P cho phép phát hiện và bù chính độ dịch phổ lớn ($\pm 50\%$) vì vậy có khung chuẩn năng lượng không cần dùng nguồn phóng xạ.

Tốc độ hiệu chỉnh dịch phổ là 12% /phút khi $\Delta T = 2s$, $f_1 = 32\text{Hz}$, $\Delta K = 0,4\%$ giúp máy có thể hoạt động ổn định ngay sau khi bật máy 5 phút.

Khối O. D. P đã được ghép với máy phổ đơn kênh U-10 do bộ môn Điện tử hạt nhân tạo. Sau 8 giờ làm việc độ dịch phổ không quá $\pm 1\%$, số đếm trong kênh phổ sai khác không quá $\pm 5\%$.

Khối O. D. P tiêu thụ 9V DC, 40 mA, cho phép ghép với hầu hết các máy đã ngo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Instruction manual GAD-6, four channels stabilized gamma-Ray spectrometer. Canada 1980-p. 3
2. Ngô Văn Thành, Nguyễn Hữu Xý, Tạp chí Khoa học DHTH Hà Nội, số 2, tr. 27 (1988).
3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации скважинного гамма - спектрометра 83, 2, 1979.
4. Ю. Р. Носов. Опто Электроник. "Советское радио", Москва, 1977.

Ngo Van Thanh, Nguyen Huu Xy - STABILIZED GAMMA-RAY SPECTROMETER WITH STANDARD LIGHT PULSES FROM LED

A stabilized gamma-ray spectrometer with a standard light pulsed source is described. The calibration of the spectrometer is automatic. During the period of 8 working hours the spectrum does not change more than $\pm 1\%$.

Bộ môn DTHN - DHTH Hà Nội

Ngày

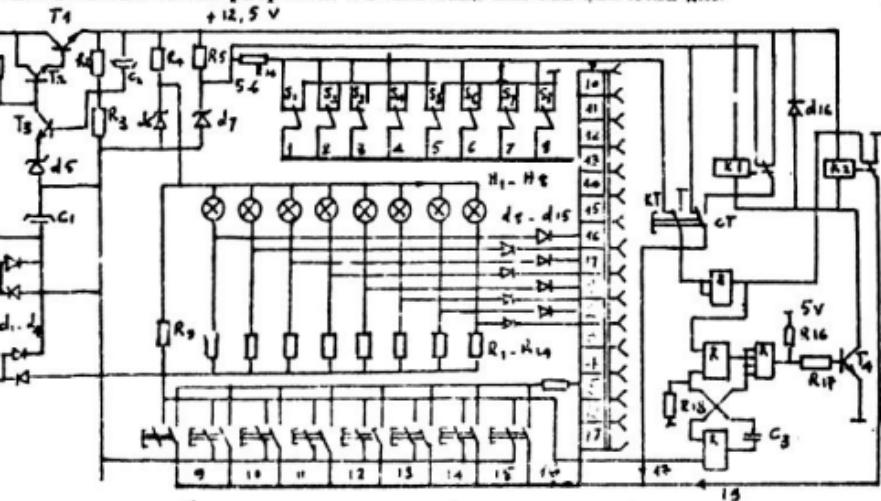
THIẾT BỊ NẠP CHƯƠNG TRÌNH CHO VI MẠCH MHÓ PROM DUNG LƯỢNG 32×8 BIT

VƯƠNG ĐẠO VY, GIANG MẠNH H

Các PROM loại cầu chì nóng chảy và diốt đổi nhau đều có thể nạp chương trình bằng cách编程. Thông thường nạp chương trình cho PROM được thực hiện nhờ máy tính. Những vi mạch có dung lượng nhớ lớn và mang tính hàng loạt [1]. Trong điều kiện thí nghiệm, đối với những vi mạch có dung lượng nhớ bé, chương trình nạp vào có tính chất

bị nạp chương trình bằng tay là thích hợp vì nó mang tính kinh tế và cơ động cao [2].
 ập chương trình bằng tay được giới thiệu dưới đây nhằm vào các vi mạch PROM có
 g 256 bit được tổ chức thành 32 lõi 8 bậc [3]. Với dung lượng như thế những vi mạch
 thích hợp cho các máy tự động loại nhỏ, cho những hệ ghi-do trong các nghiên cứu ở P.
 [4]

ghi thông tin vào các vi mạch này xảy ra trong khoảng thời gian của tín hiệu chọn \bar{s}
 nguồn nuôi và thế trên bậc cần ghi của lõi đã chọn được nâng cao. Thiết bị nạp chương
 trình thiết kế theo sơ đồ nguyên lý trên hình vẽ sau thỏa mãn yêu cầu vừa nêu của quá trình
 tin vào ô nhớ và cho phép kiểm tra tính đúng đắn của quá trình ghi.



Thiết bị nạp chương trình cho PROM

Hình 1

chế độ ghi (nạp chương trình), P được chuyển về phía "CT", địa chỉ được chọn nhờ $s_1 + s_6$ (s_6, s_7, s_8 dành cho các IC có dung lượng lớn hơn), thứ tự bậc cần ghi thông tin đã chọn được xác định nhờ các phím $s_9 + s_{10}$. Khi ấn một trong các phím $s_9 + s_{10}$ sẽ xung thế âm có độ kéo dài phụ thuộc $R_{18}C_3$. Xung này mở T₄, dòng collector của nó đi K₁ và K₂. Các role này làm việc tạo logic "0" & lối vào $\bar{c}\bar{s}$ và nâng thế nguồn nuôi V_{cc} lên +12V. Điện áp +12V qua R₁₅ đồng thời tác dụng lên lối ra tương ứng của bậc cần ghi. Kết thúc thời gian kéo dài xung, bit thông tin đã được ghi vào ô nhớ mong muốn. Để ghi tiếp bit thông tin khác hoặc kiểm tra bit thông tin đã được ghi. Chế độ kiểm tra, P được chuyển về "KT", địa chỉ của lõi cần kiểm tra được chọn nhờ $s_1 + s_5$, trạng các bậc của lõi sẽ được chỉ thị qua các đèn H₁ + H₈. Theo dõi H₁ + H₈ ta kiểm tra tính đúng đắn của quá trình nạp chương trình.

bị nạp chương trình có các thông số điện sau:

ng điện trên lối vào $\bar{c}\bar{s}$ của PROM: OV kéo dài 700 mgy

ng thế trên lối vào V_{cc} của PROM: +12V kéo dài 700 mgy.

ng điện trên bậc ra được chọn: +12V kéo dài 700 mgy

bị được nuôi bằng các thế ổn áp +5V, +7,5V và +12,5V biến đổi từ nguồn điện lưới

$$\pm 0,25V \quad I_{max} = 150 \text{ mA}^+$$

$$V \pm 0,3V \quad I_{max} = 240 \text{ mA}$$

$$5V \pm 0,5V \quad I_{max} = 600 \text{ mA}$$

Ở cảm biến mạch, các công tắc phím ấn, đèn chỉ thị ... được bố trí trên mặt máy để cho các thao tác nạp chương trình và kiểm tra. Do kết cấu gọn nhẹ, đơn giản trong sử dụng thành không cao, thiết bị này khá phù hợp với điều kiện P. T. N.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ф. Вайда, А. Чакань "Микро - «ВМ», стр. 76 - 84, Энергия М., 1980.
2. В помощь радиолюбителю выпуск 78, стр. 64 - 65.
3. R - S Components International Edition, November 1985 - February 1986.
4. Международный цынпозум по ядерной электронике, стр. 248 - 249, Дубна 1978.

Vuong Dao Vy, Giang Manh Khoi - THE PROGRAMMING APPARATUS FOR PROM WITH 32 × 8 BIT

This apparatus is used for manual entering a program into a PROM with 32×8 bit. The correctness of the programming can be checked by the indicators on the self-apparatus.

Bộ môn ĐHTN - ĐHTH Hà Nội

Nhận ngày 2

PHỐ KẾ GAMMA DK - 1024

TRẦN MẠNH TOÀN, NGUYỄN TRIỆU T

Phố kế gamma đa kênh hiện đang có nhu cầu ứng dụng thực tiễn trong: 1. Phản hoạt; 2. Phân tích huỳnh quang tia X; 3. Đo xạ gamma tự nhiên toàn thân. Phố kế gamma - 1024 trên cơ sở máy vi tính Apple II, các module chức năng chuẩn IAEA, ADC-1024 đã được thiết kế chế tạo cho các mục đích trên.

I. MÔ TẢ PHỐ KẾ GAMMA ĐA KÊNH ĐK-1024

Trên hình 1 là sơ đồ khối chức năng của ĐK - 1024. Các module chuẩn IAEA [1] : khuếch đại, nguồn thấp áp PA-14.201, 101, 901, detector nhấp nháy BICRON 2M 2/2 - 1, nồng độ đáp ứng các phép đo phổ gamma đa kênh. Module ADC - 1024 được thiết kế phối hợp với máy vi tính Apple II. Các ưu việt của giải pháp mạch được chọn gồm:

1. Đặc kết kinh nghiệm nhiều Pattern mới về ADC Willkingson,
2. Có độ tin cậy chính xác cao,
3. Khả năng chịu nước,
4. Chế độ random DMA của máy vi tính Apple II đặc biệt thích hợp cho quá trình phổ nhanh.